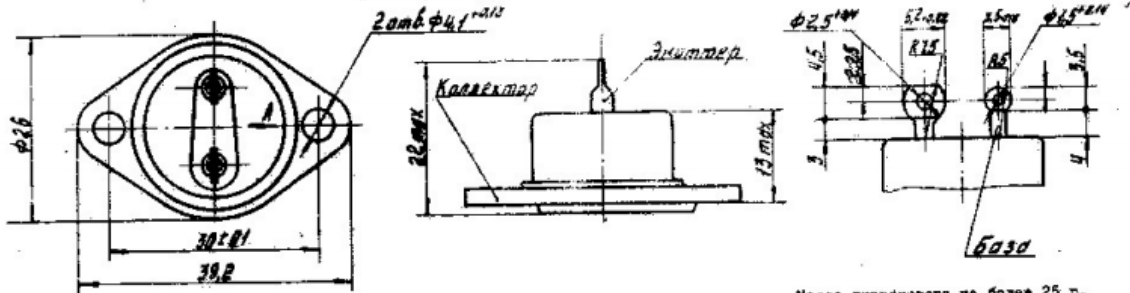




ПАСПОРТ

ТРАНЗИСТОР СИЛОВОЙ КРЕДИТОВАЯ П-Р-П ТИПА ТК-235-63
 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКОМУ УТВЕРЖДЕНИЮ № 216.179.311-41



Масса транзистора не более 25 г.
 В одном транзисторе содержится
 0,00004125 г. золота и 0,0213 г. серебра.

1. Транзисторы по максимально допустимому напряжению коллектор-база
 делятся на классы.

Класс	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база, В.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы равно нулю, В.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер при заданном значении сопротивления в цепи база-эмиттер = 3,4 ом. В.		Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер, при заданном обратном напряжении эмиттер-база 3 В.	
	$U_{кб0}$	$U_{кб1}$	$U_{кэ0}$	$U_{кэ1}$	$U_{кэ2}$	$U_{кэ3}$	$U_{кэ4}$	$U_{кэ5}$
0,5	50	50	30	30	45	45	45	45
1,0	100	100	60	60	90	90	90	90
1,5	150	150	90	90	135	135	135	135
2,0	200	200	120	120	180	180	180	180
2,5	250	250	150	150	225	225	225	225
3,0	300	300	180	180	270	270	270	270
3,5	350	350	210	210	315	315	315	315
4,0	400	400	240	240	360	360	360	360
5,0	500	500	300	300	450	450	450	450
6,0	600	600	360	360	540	540	540	540

2. Транзисторы по напряжению насыщения коллектор-эмиттер делятся на группы.

Обозначение группы	Класс	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, не более:
1	0,5 - 2,0	0,6
2	0,5 - 6,0	1,5
3	0,5 - 6,0	2,0

3. Основные параметры.

Наименование параметра и режим измерения	Обозначение	Класс	Н о р м а	
			Не менее	Не более
1. Максимально допустимый импульсный ток коллектора при температуре корпуса $+85^{\circ}\text{C}$, $I_c = 100\text{мА}$, скважности 2,	$I_{КМ\text{max}}$	Все классы		50
2. Статический коэффициент передачи тока, при $I_{К25} = 25\text{ А}$, $U_{КЭ} = 5\text{ В}$	$h_{21э}$	0,5-2,0	10	100
3. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, при $I_{К25} = 25\text{ А}$, $I_{Э} = 4\text{ А}$, В	$U_{КЭ\text{нас}}$	2,5-6,0	8	100
4. Время выключения, при $I_{К} = 25\text{ А}$, $I_{Э} = 4\text{ А}$, $U_{КЭ} \leq U_{КЭ\text{нас}}$	$t_{вкл}$	0,5-6,0		2
5. Время включения, при $I_{К} = 25\text{ А}$, $I_{Э} = 4\text{ А}$, $U_{КЭ} \leq U_{КЭ\text{нас}}$	$t_{вкл}$	0,5-2,0		0,35
	$t_{вкл}$	2,5-6,0		1,00
6. Обратный ток коллектор-база, при $U_{КЭ} = U_{КЭ0}$, мА	$I_{КЭ0}$	0,5-2,0		1,00
7. Обратный ток эмиттера, при $U_{КЭ} = 4\text{ В}$, мА	$I_{Э0}$	2,5-6,0		3,00
8. Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-к}$	0,5-6,0		10
				150
				0,7

4. Пределы допустимых эксплуатационных параметров

Наименование параметра	Обозначение	Класс	Допустимые значения параметра
1. Максимально допустимый постоянный ток коллектора, при температуре корпуса $+85^{\circ}\text{C}$, $I_{К1} = 0,2 I_{КМ\text{max}}$ А	$I_{КМ\text{max}}$	Все классы	40
2. Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_{Б\text{max}}$	Все классы	13
3. Максимально допустимый импульсный ток базы, А	$I_{БМ\text{max}}$	Все классы	16
4. Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\text{max}}$	0,5-2,0	4
5. Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	T_{max}	2,5-6,0	6
		Все классы	150

5. Условия хранения транзистора

Интервал температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха 90% при 27°C

6. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода транзистора в эксплуатацию.
Срок хранения - 3 года.

7. Указания и рекомендации по эксплуатации

Крепление транзисторов осуществляется при помощи припаянных фланца корпуса к теплоотводу с учетом зазора эмиттер не менее $0,4\text{ мм} \pm 0,05$, деформация фланца не допускается.
Монтаж транзистора должен обеспечивать надежный электрический и тепловой контакт между основанием транзистора и охлаждаемым. Запрещается кручение выводов вокруг осей. При включении транзистора в схему, охлаждаемую под напряжением, базовый вывод присоединяется первым и отключается последним.
В процессе работы транзисторов запрещается превышать предельно допустимые значения токов, напряжений и мощностей, использовать транзистор в каких-либо экстремальных режимах.

При работе транзисторов рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру корпусов, например, за счет рационального размещения транзисторов в блоках аппаратуры.

31. 03. 86 г.

Подпись: _____
Имя ОТК

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае преждевременного выхода транзистора из строя, возвратить транзистор предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____

Общее число часов работы транзистора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причины снятия транзистора с эксплуатации или хранения _____

Сведения заложки _____

ВНИМАНИЕ!

ОТК просит по окончании эксплуатации транзисторов возвратить заполненный паспорт предприятию-изготовителю.